
	<p><b>MDS1100</b></p>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">MDS1100</a></p> <hr/> <p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">Microsemi</a></p> <hr/> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> TRANS RF BIPO 8750W 100A 55TU1</p> <hr/> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">MDS1100.pdf</a></p> <hr/> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 2545 pcs Stock Available.</p> <hr/> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <hr/> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen	
Artikelnummer	<a href="#">MDS1100</a>
Hersteller	<a href="#">Microsemi</a>
Beschreibung	TRANS RF BIPO 8750W 100A 55TU1
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-Bipolar</a>
Teilstatus	2545 pcs Stock
Spannung - Kollektor-Emitter-Durchbruch (max)	65V
Transistor-Typ	NPN
Supplier Device-Gehäuse	55TU-1
Serie	-
Leistung - max	8750W
Verpackung	Bulk
Verpackung / Gehäuse	55TU-1
Betriebstemperatur	200°C (TJ)
Rauschzahl (dB Typ @ f)	-
Befestigungsart	Surface Mount
Gewinnen	8.9dB
Frequenz - Übergang	1.03GHz
DC Stromgewinn (HFE) (Min) @ Ic, VCE	20 @ 5A, 5V
Strom - Kollektor (Ic) (max)	100A

Sie können auch interessiert

sein:

 <p><b>MDS100BP-16</b> IGBT Module IGBT Modules</p>	 <p><b>MDS130-16</b> IGBT Module IGBT Modules</p>	 <p><b>MDS100G-16</b> SILING SILING New</p>	 <p><b>MDS110L</b> MICROSE MICROSE SOP4</p>
 <p><b>MDS100D-16</b> NO NO New</p>	 <p><b>MDS100F-16</b> IGBT Module IGBT Modules</p>	 <p><b>MDS110-16</b> IGBT Module IGBT Modules</p>	 <p><b>MDS1306EURH</b> MAGNACHIP MAGNACHIP SOP-8</p>

**MDS1100** Zugehöriges Mehr

Schlüsselwort	MDS1100 Datenblatt	MDS1100-Datenblätter	MDS1100 PDF	Microsemi MDS1100
MDS1100 Electronic	MDS1100-Komponenten	MDS1100-Verteiler	MDS1100-Bild	MDS1100-Teil
MDS1100 Preis	MDS1100 Hersteller	MDS1100 Bild	MDS1100 Aktie	MDS1100 Inventar
MDS1100 Neu	MDS1100 Original	MDS1100 garantiert	MDS1100 RFQ	MDS1100 Online bestellen